

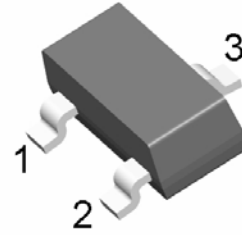
General Purpose Transistors 通用三極管

FHTA56R

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

Complementary to FHTA06R 與 FHTA06R 互補

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS(T_a=25°C) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V _{CEO}	-80	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V _{CBO}	-80	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V _{EBO}	-4.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續	I _C	-500	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P _C	300	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T _j , T _{stg}	150, -55 ~150	°C

DEVICE MARKING 打標

h_{FE} (1) FHTA56R=R2G

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(T_A=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I _{CBO}	V _{CB} =-80V, I _E =0	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I _{CEO}	V _{CE} =-80V, I _C =0	—	—	-1	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	V _{(BR)CEO}	I _C =-1.0mA	-80	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	V _{(BR)CBO}	I _C =-1.0 mA	-80	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	V _{(BR)EBO}	I _E =-100μA	-4.0	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	h _{FE} (1)	V _{CE} =-1V, I _C =-10mA	100	—	—	—
	h _{FE} (2)					
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	V _{CE(sat)}	I _C =-100mA, I _B =-10mA	—	—	0.25	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V _{BE}	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA	—	—	-1.2	V
Transition Frequency 特徵頻率	f _T	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA, f=100MHz	50	—	—	MHz